

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成18年10月19日(2006.10.19)

【公開番号】特開2005-285197(P2005-285197A)

【公開日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【年通号数】公開・登録公報2005-040

【出願番号】特願2004-95876(P2004-95876)

【国際特許分類】

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 17/00 6 3 4 C

G 1 1 C 17/00 6 3 4 B

G 1 1 C 17/00 6 3 2 A

G 1 1 C 17/00 6 4 1

G 1 1 C 17/00 6 1 1 A

【手続補正書】

【提出日】平成18年8月31日(2006.8.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項4】

前記半導体記憶装置は、前記選択メモリセルのデータ読出基準の参照電流を生成する参照セルをさらに備え、

前記センス増幅回路は、

前記読出部として作用するカレントミラーハン段と、

基準バイアス電圧により伝達電圧レベルが制限され、前記プリチャージ段からの電流を前記選択メモリセルおよび前記参照セルに供給する電圧供給段と、

前記選択メモリセルおよび前記参照セルがそれぞれ結合されるデータ線を所定電位に初期設定する初期段と、

前記カレントミラーハン段の出力ノードをイコライズするイコライズ段とを備える、請求項1記載の半導体記憶装置。